

## 2T8144A,A1,A2;Б,Б1,Б2;В,В1,В2

# Мощный высоковольтный переключательный транзистор

Кремниевые планарные N-P-N мощные высоковольтные переключательные транзисторы в металlostеклянном корпусе КТ-9, металлокерамических корпусах КТ-9М, КТ-9МИ(с изолированным фланцем) предназначены для использования в преобразователях частоты системы энергоснабжения самолетов, для работы в переключающих схемах импульсных модуляторов, во вторичных источниках питания и другой аппаратуре широкого применения.



## Максимальные электрические характеристики

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Букв. обознач.	Норма			Примечание
		2Т8144А; 2Т8144А1; 2Т8144А2	2Т8144Б; 2Т8144Б1* 2Т8144Б2*	2Т8144В; 2Т8144В1; 2Т8144В2	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	U <sub>кб</sub> max	800	600	1000	1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	U <sub>К</sub> max	25	25	25	1
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	I <sub>КИ</sub> max	40	40	40	1
Максимально допустимый ток базы, А	I <sub>Б</sub> max	6	6	6	1
Максимально допустимый импульсный ток базы, А	I <sub>би</sub> max	12	12	12	1
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре корпуса от минус 60°С до 25°С, Вт	P <sub>к</sub> max	150	150	150	2
Максимально допустимая температура перехода, °С	T <sub>пер</sub> max	150	150	150	
Максимально допустимая температура корпуса, °С	T <sub>К</sub> max	125	125	125	

## Электрические характеристики

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Букв. обознач	Норма						Температура корпуса,С
		2Т8144А; 2Т8144А1; 2Т8144А2		2Т8144Б; 2Т8144Б1*; 2Т8144Б2*		2Т8144В; 2Т8144В1; 2Т8144В2		
		не	не	не	не	не	не	

		менее	более	менее	более	менее	более	
Обратный ток коллектора, мА ( $U_{кб} = 800 \text{ В}$ ), мА  ( $U_{кб} = 600 \text{ В}$ ), мА  ( $U_{кб} = 1000 \text{ В}$ ), мА	$I_{кбо}$		1 5 5		1 5 5		1 5 5	25 -60 125 25 -60 125 25 -60 125
Обратный ток эмиттера, мА ( $U_{эб} = 5 \text{ В}$ )	$I_{эбо}$		1		1		1	25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_{к} = 16 \text{ А}$ ; $I_{б} = 3,2 \text{ А}$ )	$U_{кэ \text{ нас}}$		1,2 2,5 1,5		1,2 2,5 1,5		1,5 2,5 2,0	25 -60 125
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_{к} = 16 \text{ А}$ ; $I_{б} = 3,2 \text{ А}$ )	$U_{бэ \text{ нас}}$		2,5		2,5		2,5	25
Граничное напряжение, В ( $I_{к} = 0,1 \text{ А}$ ; $L=25 \text{ мГн}$ )	$U_{кэо \text{ гр}}$	450		400;450*		450		25
Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт	$R_{Т \text{ П-К}}$		0,83		0,83		0,83	
Энергия вторичного пробоя ( $L=0,3 \text{ мГн}$ , $U_{бэ} = -5 \text{ В}$ , $U_{кэ} = 300 \text{ В}$ , $I_{к} = 25 \text{ А}$ , $I_{б} = 5 \text{ А}$ ), мДж	$E_{ВП}$	93		93		93		25

Примечание - Параметры с \* относятся к группам транзисторов Б1, Б2.

Временные характеристики

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Букв. обознач	Норма						Температура корпуса,С
		2Т8144А; 2Т8144А1; 2Т8144А2		2Т8144Б; 2Т8144Б1*; 2Т8144Б2*		2Т8144В; 2Т8144В1; 2Т8144В2		
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
Время включения (U <sub>к</sub> =300В , I <sub>к</sub> =10А, I <sub>Б1</sub> = 2А ), мкс	t <sub>вкл</sub>		0,4		0,4		0,4	25
Время рассасывания (U <sub>к</sub> =300В , I <sub>к</sub> =10А, I <sub>Б1</sub> = - I <sub>Б2</sub> = 2А ), мкс	t <sub>рас</sub>		2,0		2,0		2,0	25
Время								

спада ( $U_K=300B$ , $I_K=10A$ , $I_{B1} = - I_{B2} = 2A$ ), мкс	$t_{сп}$	0,5	0,5	0,5	25
---	----------	-----	-----	-----	----